

Чертежи прилагаются к ТУ.

Металлизация лицевой стороны транзистора – алюминий, обратной стороны – серебро.

В.4 Масса транзисторов приведена в таблице В.2.

Таблица В.2

Условное обозначение транзисторов	Масса, г, не более
2П707Б-5	0,037
2П707В-5	0,037
2П767В-5	0,0287
2П767Ж-5	0,0287
2П768К2-5	0,037
2П768П-5	0,037
2П770К-5	0,042
2П770К2-5	0,037
2П770П-5	0,037
2П782Ж-5	0,037
2П782Ж2-5	0,037
2П793Б-5	0,0432
2П794А-5	0,0625
2П794А1-5	0,071
2П794В-5	0,071
2П794Б-5	0,0625
2П795А-5	0,073
2П795А4-5	0,071
2П795Б-5	0,0625

В.5 Описание образцов внешнего вида транзисторов КФДЛ.430204.007Д прилагается к ТУ.

В.6 Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке соответствуют нормам, приведенным в таблице В.3.

Таблица В.3

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Бук- венное обозна- чение	Норма		Темпе- ратура среды, °С
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Начальный ток стока, мкА (U _{СИ} = 600 В, U _{ЗИ} = 0 В 2П707Б-5;	I _{С.нач}	–	25	25 ± 10
9 Зам. ДФЛК.160-10				Лист
Изм. Лист № докум.	Подп. Дата			184
21307-9		21307-8		
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

Продолжение таблицы В.3

1	2	3	4	5
$U_{СИ} = 800$ В, $U_{ЗИ} = 0$ В 2П707В-5;		—	25	
$U_{СИ} = 200$ В, $U_{ЗИ} = 0$ В 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П793Б-5;		—	25	
$U_{СИ} = 400$ В, $U_{ЗИ} = 0$ В 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5;		—	25	
$U_{СИ} = 500$ В, $U_{ЗИ} = 0$ В 2П770К-5, 2П770К2-5, 2П770П-5; 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5;		—	25	
$U_{СИ} = 60$ В, $U_{ЗИ} = 0$ В 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5)		—	25	
Ток утечки затвора, нА ($U_{ЗИ} = 20$ В, $U_{СИ} = 0$ В; $U_{ЗИ} = -20$ В, $U_{СИ} = 0$ В)	$I_{3,ут}$	—	500	25 ± 10
—		—	$ -500 $	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом ($U_{ЗИ} = 10$ В, $I_C = 1$ А, $\tau_u = 1000$ мкс 2П707Б-5; 2П707В-5; 2П767В-5; 2П767Ж-5, 2П793Б-5; 2П768К2-5, 2П770П-5; 2П768П-5; 2П770К-5, 2П770К2-5; 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5; 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5; 2П794В-5; 2П795А-5, 2П795А4-5; 2П795Б-5)	$R_{СИ.отк}$	—	2	25 ± 10
—		—	3	
—		—	0,18	
—		—	0,12	
—		—	0,55	
—		—	0,42	
—		—	0,85	
—		—	0,028	
—		—	0,3	
—		—	0,2	
—		—	0,4	
—		—	0,6	
Пороговое напряжение, В ($U_{СИ} = U_{ЗИ}$, $I_C = 10$ мА 2П707Б-5; $U_{СИ} = U_{ЗИ}$, $I_C = 250$ мкА 2П707В-5, 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П770К-5, 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5, 2П793Б-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5, 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5)	$U_{ЗИ.пор}$	2,0	5,0	25 ± 10
—		1,5	6,0	

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		185
21307-9				21307-8		
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

Окончание таблицы В.3

1	2	3	4	5
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_i = 1$ А, $U_{zi} = 0$ В, $\tau_i = 1000$ мкс)	U_{ic}	—	1,0	25 ± 10
Пробивное напряжение диода, В ($U_{zi} = 0$ В, $I_c = 10$ мА, $\tau_i \leq 500$ мкс 2П707Б-5; 2П707Б-5; 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П794А1-5, 2П794В-5; 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П795А4-5; 2П782Ж2-5)	U_{ci}	600	—	25 ± 10
		800	—	
		400	—	
		500	—	
		60	—	

В.7 Измерение пробивного напряжения диода U_{ci} проводят согласно ГОСТ 18986.24 в режимах и условиях, указанных в таблице В.3.

Погрешность измерения параметра $U_{ci} = \pm 2\%$.

В.8 Технологический процесс разделения транзисторов у потребителя в случае поставки на общей пластине должен быть согласован с предприятием-изготовителем транзисторов.

В.9 Упаковка транзисторов на общей пластине производится в потребительскую групповую тару КФДЛ.321312.018 или И94.180.131 и транспортную тару И94.171.008.

Упаковка транзисторов в кристаллах производится в потребительскую групповую тару КФДЛ.735233.001 или КФДЛ.321312.023 и транспортную тару И94.171.008.

В.10 При монтаже транзисторов в гибридные интегральные микросхемы необходимо выполнять следующие условия:

а) монтаж транзисторов в гибридные интегральные микросхемы необходимо выполнять с помощью пайки в инертной среде. Температура пайки 300 °C;

б) присоединение выводов к контактным площадкам должно производиться ультразвуковой сваркой. В качестве вывода истока должна применяться проволока марки АОЦПоМ – 250 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П707Б-5, 2П770К-5; проволока марки АОЦПоМ – 400 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П707Б-5, 2П767В-5, 2П767Ж-5, 2П768К2-5, 2П768П-5, 2П770К2-5, 2П770П-5, 2П793Б-5, 2П794А-5, 2П794А1-5, 2П794Б-5, 2П794В-5, 2П795А-5, 2П795А4-5, 2П795Б-5; две проволоки марки АОЦПоМ – 400 (ТУ 6365-051-46594157-2004) для транзисторов 2П782Ж-5, 2П782Ж2-5; в качестве

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ	Lист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		186
21307-9			21307-8			
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата

вывода затвора проволока марки АК 0,9 ПМ – 100 (ТУ 6365-051-46594157-2004);

в) выводы после ультразвуковой сварки не должны касаться структуры и боковых ребер транзистора;

г) во избежание разрушения транзистора во время приварки выводов необходимо следить, чтобы рабочий инструмент и сварные точки находились внутри контактной площадки;

д) не допускается сильное натяжение и провисание выводов;

е) не допускается разрыв (пережатие) вывода в месте сварки;

ж) при пайке транзистора не допускается затекание припоя на структуру транзистора;

и) после извлечения транзисторов из упаковки изготовителя до присоединения выводов к контактным площадкам транзисторы должны находиться в специальной камере с инертной средой не более 10 суток.

В.11 Предприятие-изготовитель транзисторов в бескорпусном исполнении гарантирует соответствие изделия требованиям АЕЯР.432140.273ТУ в течение гарантийного срока и гарантийный наработки, указанных в ТУ, при соблюдении предприятием-изготовителем изделия аналога режимов сборки, условий межоперационного хранения, проведения отбраковочных испытаний, а предприятием-потребителем правил транспортирования и хранения, а также указаний по применению, монтажу и эксплуатации, установленных РД 11 0723 и АЕЯР.432140.273ТУ.

9	Зам.	ДФЛК.160-10			АЕЯР.432140.273 ТУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		187
21307-9				21307		
Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата